

# 上海伯东代理美国原装进口 KRI 射频离子源 RFICP 220

产品名称	上海伯东代理美国原装进口 KRI 射频离子源 RFICP 220
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:RFICP 220
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

## 产品详情

KRI 射频离子源 RFICP 220上海伯东代理美国原装进口 KRI 射频离子源 RFICP 220  
高能栅极离子源, 适用于离子溅镀, 离子沉积和离子蚀刻. 在离子束溅射工艺中, 射频离子源 RFICP 220 配有离子光学元件, 可以很好的控制离子束去溅射靶材, 实现更佳的薄膜特性.  
同样的在离子束辅助沉积和离子束刻蚀工艺中, 离子光学元件能够完成发散和聚集离子束的任务.  
标准配置下射频离子源 RFICP 220 离子能量范围 100 至 1200eV, 离子电流可以超过 1000 mA.KRI 射频离子源 RFICP 220 技术参数:

阳极	电感耦合等离子体2kW & 2 MHz射频自动匹配
*大阳极功率	>1kW
*大离子束流	> 1000mA
电压范围	100-1200V
离子束动能	100-1200eV
气体	Ar, O2, N2, 其他
流量	5-50 sccm
压力	< 0.5mTorr
离子光学, 自对准	OptiBeamTM
离子束栅极	22cm
栅极材质	钼
离子束流形状	平行, 聚焦, 散射
中和器	LFN 2000, MHC 1000
高度	30 cm
直径	41 cm
锁紧安装法兰	10 " CF

KRI 射频离子源 RFICP 220 基本尺寸KRI 射频离子源 RFICP 220

应用领域: 预清洗表面改性辅助镀膜 (光学镀膜) IBAD, 溅镀和蒸发镀膜 PC离子溅射沉积和多层结构

IBSD离子蚀刻 IBE射频离子源 RFICP 220 集成于半导体设备, 实现 8寸芯片蚀刻1978 年 Dr. Kaufman 博士在美国创立 Kaufman & Robinson, Inc 公司, 研发生产宽束离子源, 根据设计原理分为考夫曼离子源, 霍尔离子源和射频离子源. 美国考夫曼离子源历经 40 年改良及发展已取得多项专利. KRi 离子源广泛用于离子清洗 PC, 离子蚀刻 IBE, 辅助镀膜 IBAD, 离子溅射镀膜 IBSD 和离子束抛光工艺 IBF 等领域, 上海伯东是美国 KRi 考夫曼离子源中国总代理. 若您需要进一步的了解 [KRi 射频离子源](#), 请参考以下联络方式上海伯东: 罗先生